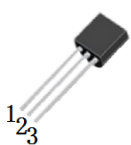
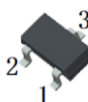


3CG111 型 PNP 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值							单位
			A	B	C	D	E	F	G	
极 限 值	P_{CM}		300							mW
	I_{CM}		50							mA
	T_{jm}		175							℃
	T_{stg}		-55~150							℃
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=0.1mA$	≥ 20	≥ 35	≥ 50	≥ 65	≥ 80	≥ 95	≥ 110	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=0.1mA$	≥ 15	≥ 30	≥ 45	≥ 60	≥ 75	≥ 90	≥ 105	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=0.1mA$	≥ 4.0							V
	I_{CBO}	$V_{CB}=10V$	≤ 0.1							μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=10V$	≤ 0.1							μA
	I_{EBO}	$V_{EB}=1.5V$	≤ 0.1							μA
	V_{BEsat}	$I_C=30mA$	≤ 1.0							V
	V_{CEsat}	$I_B=3mA$	≤ 0.5							
	h_{FE}	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	25~380							
交 流 参 数	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$ $f_o=100MHz$	≥ 200							MHz
外 引 线 说 明	 TO-92  SOT-23  A3-01B(B1) 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极									
替代型号：										